

项目名称： 面向三维集成的氧化物半导体基 DRAM，编号：8201701924，用途：在华中科技大学国家脉冲强磁场做相关工艺及测试。北京大学委托华中科技大学进行工艺服务，主要制备及表征面向三维集成的氧化物半导体基 DRAM，需要用到如原子层沉积系统、纳米图形发生系统、高真空溅射镀膜系统低温直流微波电台和多场光学低温测试平台等设备以完成栅介质沉积、图案定义、氧化物薄膜沉积、器件表征和电学测试等流程。

华中科技大学国家脉冲强磁场科学中心的原子层沉积系统 TFS Beneq200 可以制备多组分的纳米薄层和氧化物薄膜。纳米图像发生系统 Raith 精度高，最小特征尺寸 ≤ 8 nm。同时其它工艺相关设备齐全，有完成整套 DRAM 制备及表征的能力。

综合比较后华中科技大学符合本次技术服务条件、另外所收取的费用以及合同中的相关服务条款也较合理。综上本次服务选择华中科技大学完成。

课题负责人（签字）：